

D3F60

600V 3A

特長

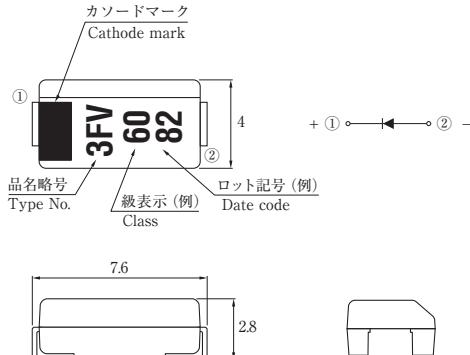
- ・小型 SMD
- ・耐湿性に優れ高信頼性
- ・高 $I_{F\text{SM}}$

Feature

- Small SMD
- High-Reliability
- Large $I_{F\text{SM}}$

■外観図 OUTLINE

Package : 2F

Unit : mm
Weight : 0.16g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

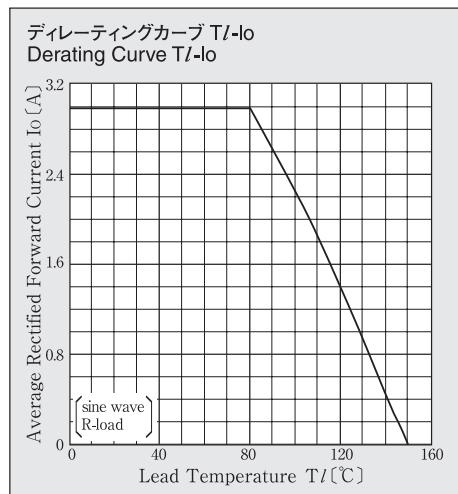
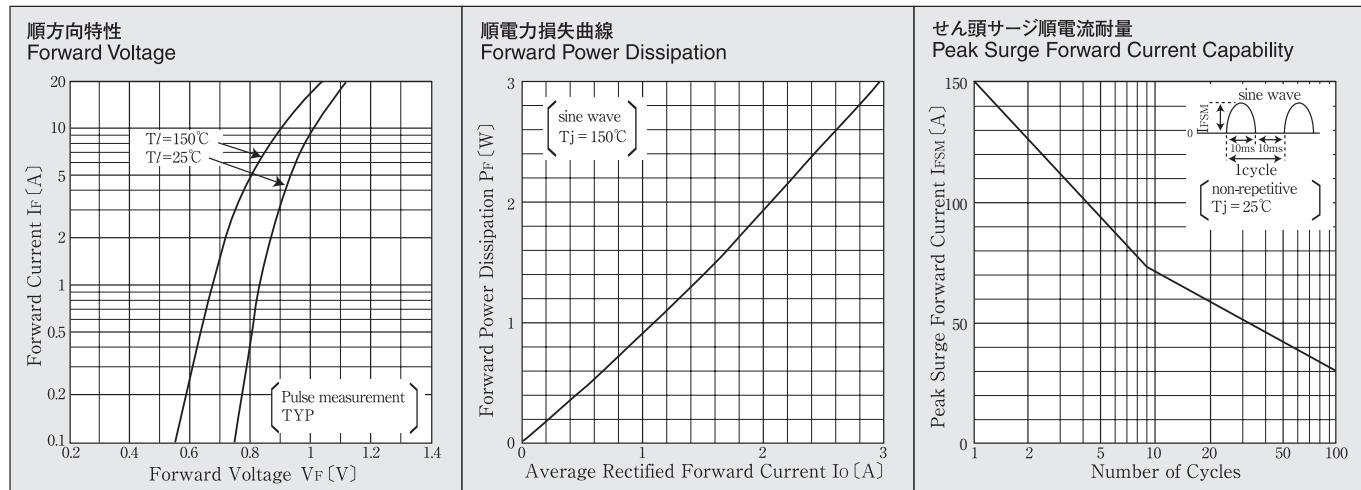
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_f = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D3F60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_f = 80^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_f = 80^\circ\text{C}$		3	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1サイクルせん頭値, $T_f = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_f = 25^\circ\text{C}$		150	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_f = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =3A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =V _{RM} , パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 23	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 80 MAX 115	
		アルミナ基板実装 On alumina substrate		
		プリント基板実装 On glass-epoxy substrate		

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.